

技術の名称

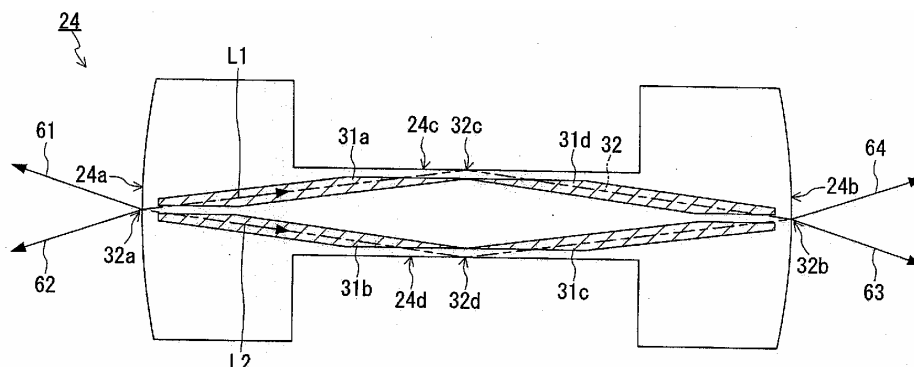
半導体レーザー装置

適用分野

レーザジャイロ、姿勢制御装置、ナビゲーション装置、手ぶれ補正装置、携帯用情報端末、航空機、自動車、バイク

- 目的 複数の方向へ出射するレーザー光の強度を個別に制御する。
- 効果 複数の方向へ出射するレーザー光の強度を個別に制御できるので、レーザジャイロを用いた各種の電子機器の利便性が向上する。
- 技術概要 半導体多層膜によって構成された活性層24とこの活性層に電流を注入する電極とを備え、活性層24は仮定の菱形の経路32を構成する4つの端面24a~24dを有し、経路32に沿って時計回り及び逆時計回りに伝播するレーザー光L1、L2の一部がレーザー光61~64として出射されるとともに、経路32の菱形を構成する4つの分割部分にそれぞれ独立した電極を設けて各分割部分に異なる量の電流を注入することによって、レーザー光61~64の強度を制御している。

■ 特記事項,図など



- 主たる提供特許 特許等の名称 : 半導体レーザー装置
登録番号 :
出願番号 : 特願2006-088726 出願日 : 平成18年3月28日
公開番号 :
- 実施実績 ○有、無 ■ 提供形態 ○実施許諾、×権利譲渡

お問合せ先 株式会社 国際電気通信基礎技術研究所(ATR) 経営統括部 知的財産チーム
〒619-0288 京都「けいはんな学研都市」光台二丁目2番地2
TEL 0774-95-2521 E-mail ; patent@atr.jp